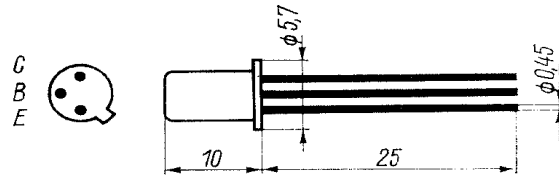


Langsamer Germanium-pnp-Schalttransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 mit hoher Basis-Emitter-Spannungsfestigkeit, geeignet für den Einsatz in Rechenmaschinen.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand
Wärmewiderstand

$R_{thja} \leq 0,38 \text{ grad/mW}$
 $R_{thjc} \leq 0,05 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0} = 30 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$	$-U_{CER} = 20 \text{ V}^1)$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$
Kollektorstrom $t_{avL} = 20 \text{ ms}$	$-I_c = 100 \text{ mA}$
Kollektorspitzenstrom	$\widehat{-I_c} = 150 \text{ mA}$
Emitterstrom	$I_E = 100 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j = +80 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperaturbereich	$-25 \text{ }^\circ\text{C} \text{ bis } +65 \text{ }^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte

		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15 \text{ V}$ $\vartheta_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	$-I_{CBO}$			$15 \mu\text{A}$	
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15 \text{ V}$ $\vartheta_a = 45 \text{ }^\circ\text{C}$	$-I_{CBO}$			$80 \mu\text{A}$	
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15 \text{ V}$ $\vartheta_a = 75 \text{ }^\circ\text{C}$	$-I_{CBO}$			$800 \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Restspannung $-U_{CB} = 0$ $-I_c = 100 \text{ mA}$	$-U_{CErest}$			$0,5 \text{ V}$	
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $-U_{CE} = 0,5 \text{ V}$ $-I_c = 100 \text{ mA}$	h_{21E}	28		56	B
		45		90	C
		71		140	D
		112		224	E

Stromverstärkungsgruppe

Dynamische Kennwerte

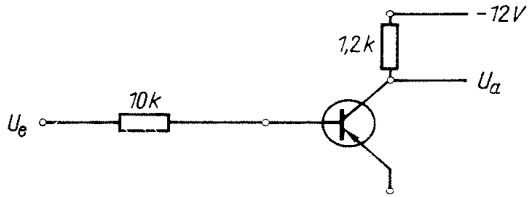
Rauschfaktor $-U_{CE} = 1 \text{ V}$ $-I_c = 1 \text{ mA}$ $f = 1 \text{ kHz}$ $\Delta f = 1 \text{ kHz}$ $R_g = 500 \Omega$	F			25 dB	
Ausschaltzeit $-U_{CE} = 12 \text{ V}$ $-I_c = 10 \text{ mA}$ $I_{B2} = 0$	t_f	$12 \mu\text{s}$		$26 \mu\text{s}$	
Siehe Meßschaltung					

Bemerkung:

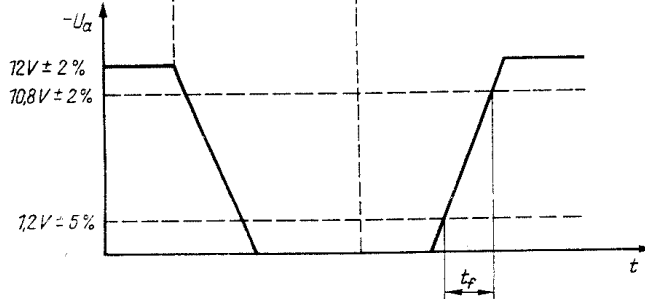
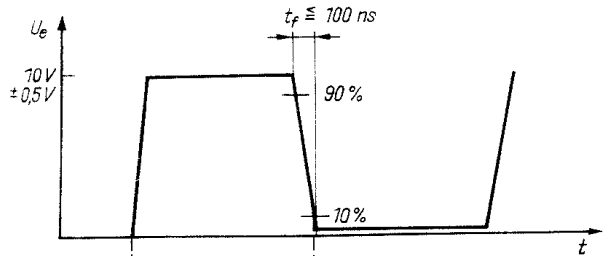
Beim Umschalten des Transistors aus dem „Ein“-Zustand (max. Verlustleistung, $\widehat{-I_{CL}} = 150 \text{ mA}$) in den Sperrzustand ($-U_{CER} = 20 \text{ V}$, $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$) darf die Widerstandsgerade zwischen den beiden Schaltzuständen nicht die Sperrkennlinie des Transistors im negativen Widerstandsbereich schneiden.

Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GS 122



Kapazitive Belastung des Ausganges
mit max. 50 pF



Folgefrequenz 3,5 kHz
Tastverhältnis 1:1
Generatorwiderstand 300 Ω

1. freitragend
2. mit Kühlfläche Al 2 mm dick vertikal montiert, unbearbeitet A = 9 cm²
3. Kühlfläche A = 25 cm²
4. Kühlfläche A = 100 cm²
5. mit angenähert idealer Kühlung

